



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

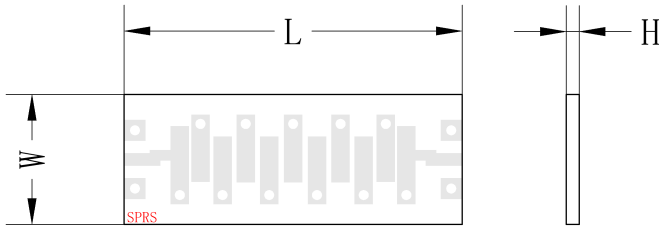
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.5	GHz
工作带宽	6.5-18.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-4.6GHz	dBc

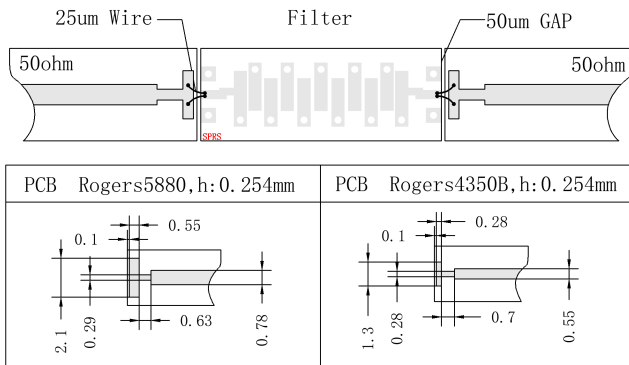
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55 ~ +85°C
储存温度	-55 ~ +125°C
外形尺寸	L: 8.5, W: 5.0, h: 0.26

外形图：端口居中



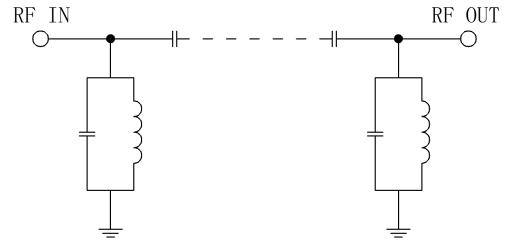
推荐装配图



注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线

